

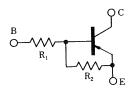
複合トランジスタ Compound Transistor FN1F4M

抵抗内蔵PNPエピタキシアル形シリコントランジスタ 中速度スイッチング用

特徴

○バイアス抵抗を内蔵しています。

 $(R_1=22 k\Omega, R_2=22 k\Omega)$



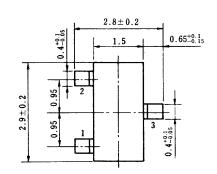
○FA1F4Mとコンプリメンタリで使用できます。

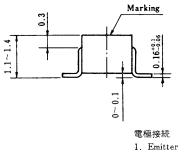
絶対最大定格 (T_a = 25 ℃)

項	B	略	号	定	格	単	位	
コレクタ・ベース間電圧		V_{CBO}		-60		1	V	
コレクタ・エミッタ間電圧		V CEO		-50		1	V	
エミッタ・ベース間電圧		$V_{\rm EBO}$		10		V		
コレクタ電流(直流)		I _{C(DC)}		-100		m	mA	
コレクタ電流(パルス)		I _{C(pulse)} *		-200		m	mA	
全	損失	P_T		2	00	m	W	
ジャンク	ション温度	T_{i}		1	.50	°(С	
保 存	温 度	Tst	g	-55	~ + 150	°(С	

*PW≤10 ms, Duty Cycle≤50 %

外形図 (単位:mm)





捺印: M32

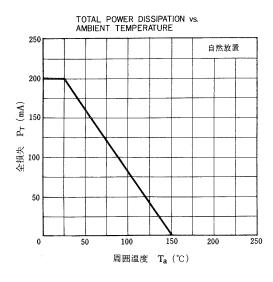
Base
Collector

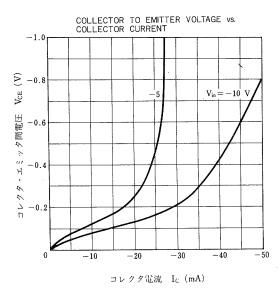
電気的特性 (T_a = 25℃)

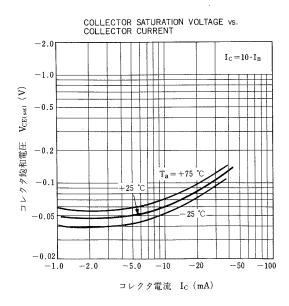
項目 略号 条件 MIN. TYP. MAX. コレクタしゃ断電流 I _{CBO} V _{CB} =-50 V, I _E =0 100	単 位 nA
コレクタしゃ断電流 I _{CBO} V _{CB} =-50 V, I _E =0 100	n A
直流電流増幅率 h _{FE1} ** V _{CE} =-5.0 V, I _C =-5.0 mA 60 85 195	
直流電流増幅率 h _{FE2} ** V _{CE} =-5.0 V, I _C =-50 mA 90 145	
コレクタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ ** $I_C = -5.0$ mA, $I_B = -0.25$ mA -0.05 -0.2	V
ロウレベル入力電圧 V_{IL} ** $V_{CE}\!=\!-5.0$ V, $I_{C}\!=\!-100~\mu A$ -1.17 -0.8	V
ハイレベル入力電圧 V _{IH} ** V _{CE} =-0.2 V, I _C =-5.0 mA -4.0 -2.0	V
入 力 抵 抗 R ₁ 15.4 22.0 28.6	kΩ
抵 抗 比 率 R ₁ /R ₂ 0.9 1.0 1.1	_
タ・- ン オ ン 時 間 t _{on} 0.23 0.5	μs
$\stackrel{\circ}{\mathbb{B}}$ 積 時 間 t_{stg} $V_{in} = -5 \text{ V}, R_L = 1 \text{ k}\Omega, V_{CC} = -5 \text{ V}$ $PW = 2 \mu \text{s}, Duty Cycle} \leq 2 \%$ 0.8 3.0	μs
ターンオフ時間 t _{off} 1.1 3.5	μs

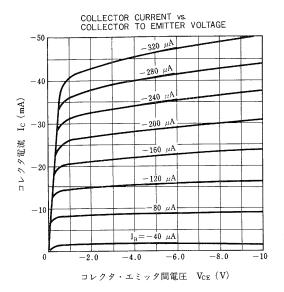
**パルス測定 PW≤350 µs, Duty Cycle≤2 %

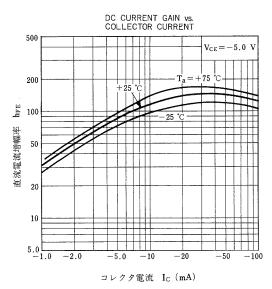
特性曲線 (T_a = 25℃)

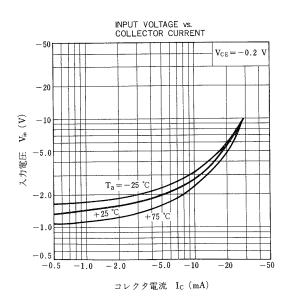


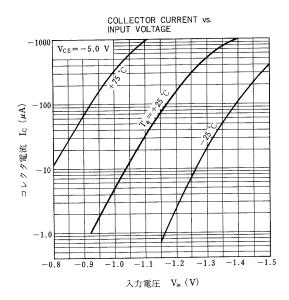


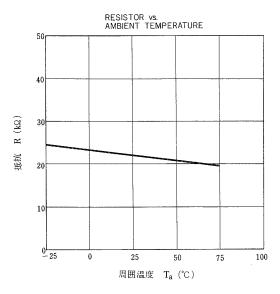


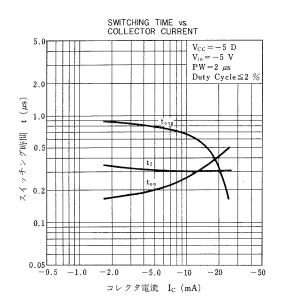












(メ モ)

·NEC 日本電気株式会社

A A M	2 日 でした スパルングス 1上
本 社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111
半導体第一、第二 販売事業部	東京都寺区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6
関 西 支 社 半導体販売部	大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 6 号 (新大阪ビル) 〒530 大阪 (06) 348 - 1 4 6 1 大阪 (06) 348 - 1 4 6 6
中 部 支 社 電子デバイス 販 売 部	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル)〒460 名古屋(052)262-3611
北 釧區旭帯東青八岩秋山郡福い圧新長MBC的工作表表 路館川広北森戸手田形山島わ内潟岡駅山道 営文支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支	札 幌(011)231-0161

Downloaded from